

- [1] a) J. A. Spencer, A. L. Mock, A. G. Jacobs, M. Schubert, Y. Zhang, M. J. Tadjer, *Applied Physics Reviews* **2022**, 9; b) A. Belosludtsev, K. Juškevičius, L. Ceizaris, R. Samuilovas, S. Stanionytė, V. Jasulaitienė, S. Kičas, *Applied Surface Science* **2018**, 427, 312.
- [2] K. Yim, Y. Yong, J. Lee, K. Lee, H.-H. Nahm, J. Yoo, C. Lee, C. Seong Hwang, S. Han, *NPG Asia Mater* **2015**, 7, e190-e190.
- [3] P. Myllymäki, M. Nieminen, J. Niinistö, M. Putkonen, K. Kukli, L. Niinistö, *J. Mater. Chem.* **2006**, 16, 563.
- [4] a) N. A. Stafford, R. Katamreddy, L. Guerin, B. Feist, C. Dussarrat, V. Pallem, C. Weiland, R. Opila, *ECS Trans.* **2009**, 19, 525; b) M. Ameen, L. Nyns, S. Sioncke, D. Lin, T. Ivanov, T. Conard, J. Meersschaut, M. Y. Feteha, S. van Elshocht, A. Delabie, *ECS J. Solid State Sci. Technol.* **2014**, 3, N133-N141.
- [5] M. Putkonen, M. Nieminen, J. Niinistö, L. Niinistö, T. Sajavaara, *Chem. Mater.* **2001**, 13, 4701.
- [6] P. de Rouffignac, A. P. Yousef, K. H. Kim, R. G. Gordon, *Electrochem. Solid-State Lett.* **2006**, 9, F45.

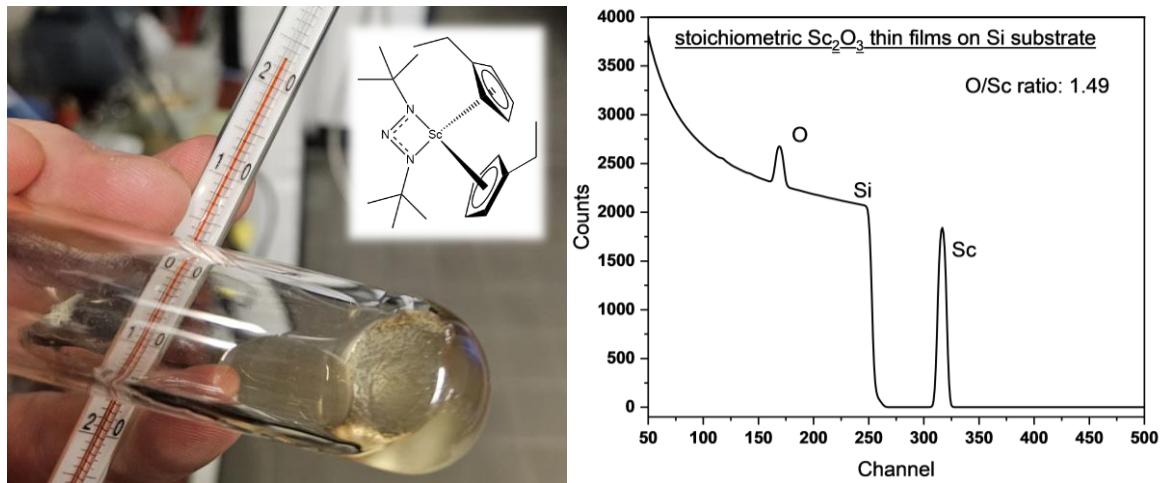


Figure 1 left: Picture and structure of ASGARD at room temperature; right: Compositional analysis of Sc_2O_3 Thin film.